

年月日

25

06

13
ページ

21

NO.

科学技術の潮流

JST研究開発戦略センター

(292)

長期の研究開発

近年、スマートフォンやノートパソコン用の小型の急速充電器に、窒化ガリウム(GaN)のパワー半導体

が使われるようになってきた。GaNは発光ダイオードへの応用がよく知られているが、パワー半導体市場の主流であるシリコン(Si)よりも高効率動作と高電圧動作が可能といった優れた材料特性を有し、40年ほど前から種々の研究開発が進められてきた。しかし、



科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター
フェロー(ナノテクノロジー・材料ユニット)
馬場 寿夫
(工学) 電気通信大学大学院電気通信学研究科心用電子工学専攻修士課程修了。電機メーカー、内閣府総合科学技術会議事務局(ナノテクノロジー・材料/ものづくり技術担当)を経て、12年より現職。博士

GaN半導体 快速充電で活躍

アプリケーションがなかなか生まれず、最近世代パワーエレクトロニクスプロジェクト」が、まだ無線基地局用など一部での実用化など、内閣府の戦略的イノベーション創造プロジェクト、「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」(16~20年度)も現れた。

炭素社会を実現する次など、GaNを含むパワー半導体関係のプロジェクトや支援が長期的に推進され、結晶作成技術やデバイス技術が高い周波数での利用が

高品質で低コストのGaN基板や、GaNの特長を生かせるキラー構(NEDO)の「低開発」(16~20年度)

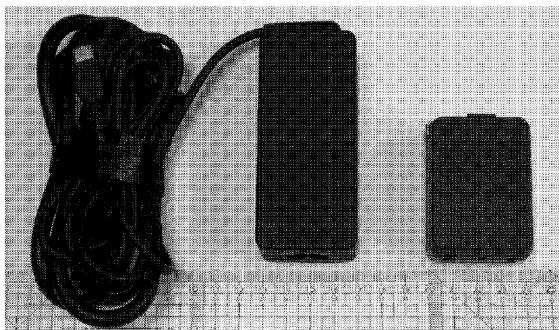
がさるに進んだ。また、欧米などでは、1996年ころから大量

のコンデンサーやコイルなどの部品の小型化が急速に進展した。日本では、新エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発など、GaN基板を用いて、GaNパワー半導体の製造を低コストで請け負う企業も現れた。

このため、Siが使用されていた低電圧用途ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの急速充電器など、小型軽量で大容量な充電器のニーズへの対応が始まつた。19年ごろからはGaNを用いたUSB急速充電器が実用化され、21年ごろから広く普及するようになった。

今後は、電気自動車や第6世代通信(G)の基地局、データセンター用電源などとともに、急速充電器など生活を便利にする身近な応用に向けた研究開発のさらなる推進により、日本の技術力・産業競争力の一層の向上を期待したい。

ノートパソコン用USB-C電源とGaN急速充電器の比較



ノートパソコン付属のUSB-C電源(左)とGaNを用いた65W急速充電器 ※ほぼ半分の体積に小型化

(金曜日に掲載)